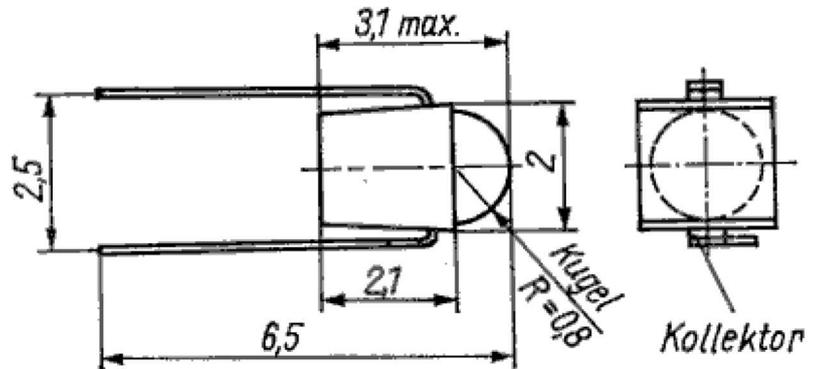


SP 212

Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Verpackung.

Die spektrale Empfindlichkeit des SP 212 ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IREDD angepaßt.

Bauform 11



Grenzwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)

		min	typ.	max
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE}	-	-	50 V
Kollektor-Emitter-Spitzenspannung	U_{DEM}	-	-	50 V
Emitter-Kollektor-Spannung	U_{EC}	-	-	7 V
Emitter-Kollektor-Spitzenspannung	U_{ECM}	-	-	7 V
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	-	-	100 mW
Wärmewiderstand	R_{th}	0,65	-	- K/mW
Betriebstemperatur	ϑ_a	-40 bis 85 °C		
Lagerungstemperatur	ϑ_{stg}	-50 bis 100 °C		
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	90 °C		

Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)

		min.	typ.	max.
Kollektorstrom $E_e = 0; U_{CE} = 25\text{ V}$	I_{CO}	-	5	100 nA
Kollektorstrom $E_v = 1\ 000\text{ lx}, U_{CE} = 5\text{ V}$	I_C	0,4	1,0	- mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $E_v = 1\ 000\text{ lx}, I_{CE} = 0,25\text{ mA}$	U_{CEsat}	-	0,2	- V
Wellenlänge der max. spektralen Empfindlichkeit	λ_{max}	-	850	- nm
Spektraler Empfindlichkeitsbereich	$\Delta\lambda$	von 450 bis 1 050 nm		
Schaltzeiten bei $I_C = 800\ \mu\text{A}, U_B = 35\text{ V}; R_L = 1\ \text{k}\Omega$	t_r	-	4	10 μs
	t_f	-	4	10 μs
Kapazität Kollektor-Emitter $f = 1\ \text{MHz}, U_{CE} = 0; E_e = 0$	C_{CE}	-	3	- pF